Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0401U001289

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 07-05-2001

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:

II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Гайдар Галина Петрівна
2. Gajdar Galyna Petrivna

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Вид дисертації: кандидат наук

Аспірантура/Докторантура: так

Шифр наукової спеціальності: 01.04.07

Назва наукової спеціальності: Фізика твердого тіла

Галузь / галузі знань: Не застосовується

Освітньо-наукова програма зі спеціальності: Не застосовується

Дата захисту: 27-04-2001

Спеціальність за освітою: 7.070201

Місце роботи здобувача: Науковий центр "Інститут ядерних досліджень" НАН України

Код за ЄДРПОУ: 23724640

Місцезнаходження: МСП-03680, м. Київ-28, пр. Науки, 47

Форма власності:

Сфера управління: Національна академія наук України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): К 26.199.01

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

IV. Відомості про підприємство, установу, організацію, в якій було виконано дисертацію

Повне найменування юридичної особи: Науковий центр "Інститут ядерних досліджень" НАН України

Код за ЄДРПОУ: 23724640

Місцезнаходження: МСП-03680, м. Київ-28, пр. Науки, 47

Форма власності:

Сфера управління: Національна академія наук України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації:

Коди тематичних рубрик: 29.19.13, 29.19.21

Тема дисертації:

1. Особливості анізотропії розсіяння електронів у кристалах Si і Ge n-типу, що виникають під впливом направленої пружної деформації, термовідпалів і ядерної радіації

2. The features of the scattering anisotropy in the n-Si and n-Ge crystals which appear under the influence of the axial elastic deformation, heat treatment and the nuclear irradiation

Реферат/анотація:

1. Об'єкт: кінетика електронних процесів і залежність останніх від анізотропії розсіяння електронного газу на коливаннях кристалічної гратки n-Si і n-Ge, а також на домішкових центрах різної природи в їх об'ємі. Мета: комплексне дослідження особливостей анізотропії розсіяння і ролі радіаційних дефектів у формуванні електрофізичних властивостей Si і Ge n-типу при різному рівні легування і з врахуванням наявності в них залишкових домішок в умовах впливу зовнішніх полів. Методи: звичайний і парний ефект Холла, вимірювання питомого опору, магнітоопору, термо-е.р.с. Основні результати: отримано значення констант деформаційного потенціалу зсуву в нейтронно-опромінених кристалах n-Si, параметрів анізотропії рухливості і анізотропії термо-е.р.с. в умовах прояву ефекту захоплення електронів фононами, дослідження впливу ступеня компенсації на вказані ефекти.

2. Object of investigation: kinetic of electron processes and they dependence from anisotropy of electron gas scattering on lattice vibration and on impurity centers (with different origin mechanism) in n-Si and n-Ge. Aim of work: complex investigation of scattering anisotropy peculiarities and role of radiation defects in the formation of electro-physical properties of n-type Si and Ge under various doping level and taking into account the existing of the trace impurities for conditions of external fields action. Methods: Even and ordinary Hall effects, measurements of resistance, magneto-resistence, thermo- electromotive force. Main results: the values of deformation potential constants in neutron irradiated n-Si crystals and the parameters of anisotropy for electron gas scattering and anisotropy of thermo-electromotive force have been obtained. The influence of compensation level on such processes has been studied.

Державний реєстраційний номер ДіР:

Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки:

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:

Підсумки дослідження:

Публікації:

Наукова (науково-технічна) продукція:

Соціально-економічна спрямованість:

Охоронні документи на ОПІВ:

Впровадження результатів дисертації:

Зв'язок з науковими темами:

VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Литовченко П.Г.

2. Литовченко П.Г.

Кваліфікація: д.ф.-м.н., 01.04.10

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів

Офіційні опоненти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Блонський І.В.

2. Блонський І.В.

Кваліфікація: д.ф.-м.н., 01.04.07

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Романюк Б.М.

2. Романюк Б.М.

Кваліфікація: д.ф.-м.н., 01.04.01

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Рецензенти

VIII. Заключні відомості

Власне Прізвище Ім'я По-батькові голови ради Шейнкман М.К.

Власне Прізвище Ім'я По-батькові головуючого на засіданні Шейнкман М.К.

Відповідальний за підготовку облікових документів

Реєстратор

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності



Юрченко Т.А.